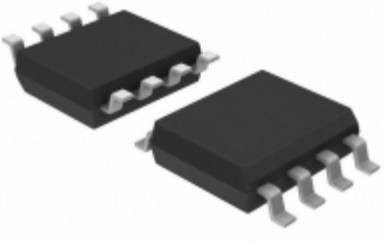



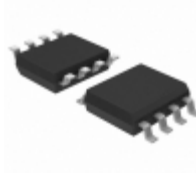


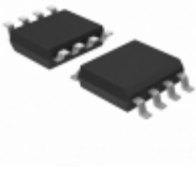

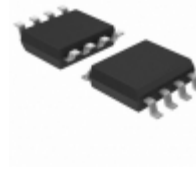
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4128DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10.9A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4128DY-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 170231 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4128DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	170231 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 10.9A (Ta) 2.4W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4128DY-T1-GE3-ND

SI4128DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4128DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4128DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4128DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4128DY VISHAY SI4128DY VISHAY</p>	 <p>SI413 Vishay Precision Group SI413 VISHAY</p>	 <p>SI4128DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 10.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4132-KT Silicon Silicon TSSOP</p>
 <p>SI4132-BT Silicon Silicon TSSOP</p>	 <p>SI4128DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 10.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4128DY-T1-GE3 Vishay Precision Group SI4128DY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI4128DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 10.9A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ⚙ SI4114DY-T1-GE3 | ➔ SI4114DY-T1-GE3 | ➔ SI4116DY | D SI4116DY-T1-E3 | ➔ SI4116DY-T1-E3 |
| ⊖ SI4116DY-T1-GE3 | ⚙ SI4116DY-T1-GE3 | D SI4122-BTR | ➔ SI4122-D-GMR | ➔ SI4122DY-T1-E3 |
| ⚙ SI4122G-BMR | ⊖ SI4123-BM | ⚙ SI4124DY-T1-E3 | ➔ SI4124DY-T1-E3 | ➔ SI4124DY-T1-GE3 |
| D SI4124DY-T1-GE3 | ⚙ SI4126-BMR | ⊖ SI4126DY-T1-E3 | ⚙ SI4128BDY | ➔ SI4128BDY-T1-GE3 |
| ➔ SI4128BDY-T1-GE3 | ➔ SI4128DY | ⚙ SI4128DY-T1 | ⊖ SI4128DY-T1-E3 | ➔ SI4128DY-T1-E3 |
| ➔ SI4128DY-T1-GE3 | ➔ SI4133-D-GM | D SI4133G-BT | ⚙ SI4133T-BM | ⊖ SI4133T-BMR |
| ⚙ SI4133W-BMR | D SI4133X1-BMR | ➔ SI4134DY | ➔ SI4134DY-T1 | ➔ SI4134DY-T1-E3 |
| ⊖ SI4134DY-T1-E3 | ⚙ SI4134DY-T1-GE3 | ➔ SI4134DY-T1-GE3 | ➔ SI4134DY/T1/-GE3 | ➔ SI4134T-BMR |
| ⚙ SI4134T-GMR | ⊖ SI4136-F-GM | ⚙ SI4136-F-GMR | D SI4136DY-T1-GE3 | ➔ SI4136DY-T1-GE3 |
| ➔ SI4136XM-BT | ⚙ SI4136XM-GTR | ⊖ SI4154DY-T1-GE3 | ⚙ SI4154DY-T1-GE3 | ➔ SI4156DY |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

